

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-275203

(P2000-275203A)

(43)公開日 平成12年10月6日 (2000.10.6)

(51)Int.Cl.
G 0 1 N 27/16

識別記号

F I
G 0 1 N 27/16

デマコート (参考)
B 2 G 0 6 0

審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全4頁)

(21)出願番号 特願平11-83083

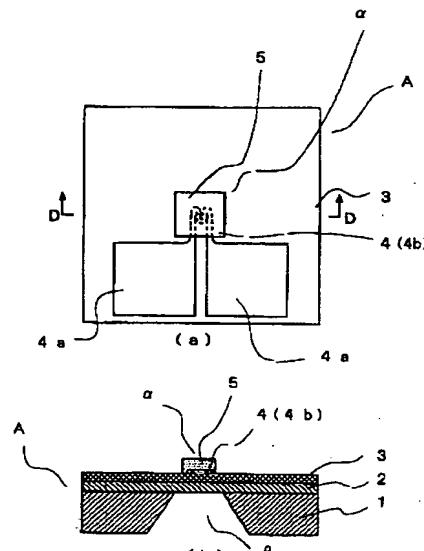
(22)出願日 平成11年3月26日 (1999.3.26)

(71)出願人 000006895
矢崎總業株式会社
東京都港区三田1丁目4番28号
(72)発明者 高島 裕正
静岡県天竜市二俣町南鹿島23 矢崎計器株
式会社内
(72)発明者 小澤 崇
静岡県天竜市二俣町南鹿島23 矢崎計器株
式会社内
(74)代理人 100060690
弁理士 濑野 秀雄 (外1名)
Fターム(参考) 2G060 AA02 AE19 AG06 BA03 BB03
BB16 BD10 HE02

(54)【発明の名称】 接触燃焼式ガスセンサ

(57)【要約】

【課題】 長寿命な接触燃焼式ガスセンサを提供する。
【解決手段】 基板ダイアフラム部に検出部を有する接
触燃焼式ガスセンサであって、該検出部の酸化触媒層の
厚さが20μm以上である接触燃焼式ガスセンサ。



α…検出部
β…ダイアフラム部
1…基板
2…酸化ケイ素層
3…窒化ケイ素層
4…ヒータ
4a…端子
4b…ヒータ部
5…酸化触媒層

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板ダイアフラム部に検出部を有する接触燃焼式ガスセンサであって、該検出部の酸化触媒層の厚さが20μm以上であることを特徴とする接触燃焼式ガスセンサ。

【請求項2】 上記酸化触媒層の厚さが300μm以下であることを特徴とする請求項1に記載の接触燃焼式ガスセンサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、接触燃焼式ガスセンサ技術に関する。

【0002】

【従来の技術】 接触燃焼式ガスセンサは、白金などからなる導電性線材の周囲に酸化触媒層を配してなり、雰囲気中の可燃ガスが酸化触媒層で雰囲気中の酸素により酸化される際に生じる燃焼熱を検出し、可燃性ガス濃度を測定するセンサである。このような接触燃焼式ガスセンサのうち、コンパクトで、周辺の電気回路と共に一体化が容易なものとして、アルミナ基板やシリコンウエハ等を基板とし、これら基板上に薄膜ヒータを形成し、さらにこの薄膜ヒータを覆うように酸化触媒層を形成してなる薄膜型接触燃焼式ガスセンサが最近用いられるようになってきた。

【0003】 この薄膜型接触燃焼式ガスセンサは、その薄膜ヒータの特性から、低消費電力であって電池駆動が可能であり、また、応答性に優れ、さらに半導体製造技術を応用することによって、小型化・大量生産が容易である。図4にこのような薄膜型接触燃焼式ガスセンサBの例を示す。

【0004】 図4(a)に上面図(白金ヒータが見えるように示してある)、図4(b)に図4(a)のDDにおける断面図をそれぞれ示す。なお、このセンサの場合、上面は3mm×3mmの正方形で、また、高さは0.4mmである。図中符号1がシリコン基板、2は酸化ケイ素層(SiO₂、厚さ5000Å)であり、この酸化ケイ素層2の上にさらに窒化ケイ素層3(Si₃N₄、厚さ2500Å)が設けられていて、これらが基板を構成している。

【0005】 この基板上に白金からなるヒータ(「白金ヒータ4」、厚さ2500Å)及びその端子4aが設けられ、この白金ヒータ4のヒータ部4bは厚さ数μmの酸化触媒層5(この例では厚さ3μmのパラジウム添着アルミナ層)により覆われている。

【0006】 なお、基板における酸化触媒層が設けられている検出部α付近の裏面はシリコン基板が異方エッチングにより除去されて薄くなっていて、酸化ケイ素層が露出してダイアフラム部βを形成している。このダイアフラム部βにより、検出部の熱容量、及び、基板への熱伝導が小さくなっていて、消費電力の低減、センサ感度

の向上に寄与している。

【0007】 このように薄膜型接触燃焼式ガスセンサは消費電力が小さく、感度の高い優れたセンサであるが、耐久性に問題があった。すなわち、比較的短時間の使用によりセンサ感度が低下し、そのため、定期的な校正作業やセンサ自体の交換作業、あるいは、測定値の補正のための特別な回路の付属による高コスト化及び高消費電力化等、本来、電池駆動によるメンテナンスフリーを目的とする分野への参入が可能とされた薄膜型接触燃焼式ガスセンサにとって、まさに陥穀とも云えるような欠点があった。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記した従来の問題点を改善する、すなわち、長寿命な接触燃焼式ガスセンサを提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】 本発明者等は、従来技術に係る接触燃焼式ガスセンサにおける感度の経時変化について詳細な検討を行ったところ、感度の経時変化はヒータを被覆している酸化触媒層の厚さに大きく影響されることを見出して本発明に至った。すなわち、本発明の接触燃焼式ガスセンサは上記従来技術に係る課題を解決するため、請求項1に記載の通り、基板ダイアフラム部に検出部を有する接触燃焼式ガスセンサであって、該検出部の酸化触媒層の厚さが20μm以上である接触燃焼式ガスセンサである。

【0010】

【発明の実施の形態】 本発明の接触燃焼式ガスセンサにおいて、基板ダイアフラム部上に設けられた検出部の酸化触媒層の厚さは20μm以上であることが必要である。20μm未満であると充分なセンサ寿命が得られない。一方300μm超である場合、消費電力が大きくなり、その結果、長期間の電池駆動が困難になってしまふため、本発明の効果を充分に活かすようなメンテナンスフリーの測定装置を構成することが困難となる。

【0011】

【実施例】 以下に本発明の接触燃焼式ガスセンサについて具体的に説明する。図1に本発明に係る接触燃焼式ガスセンサの例Aを示す。図1(a)に上面図(モデル図)、また、図1(b)に図1(a)のDDにおける断面図(モデル図)を示す。

【0012】 なお、このセンサの、上面は3mm×3mmの正方形で、高さは0.4mmである。図中符号1がシリコン製の基板、2は酸化ケイ素層(SiO₂、厚さ5000Å)であり、基板を熱酸化して得られる。この酸化ケイ素層の上にさらに強度向上のためCVDによって窒化ケイ素層(Si₃N₄、厚さ2500Å)が設けられていて、これらが基板を構成している。

【0013】 この基板上にスパッタリングにより白金製のヒータ4(厚さ2500Å)及びその端子4aが設け

られ、この白金ヒータ4のヒータ部4bはスクリーン印刷により厚さ数 μm の酸化触媒層5（この例では厚さ20 μm の15重量%パラジウム添着アルミナ層）により覆われている。なお、酸化触媒としては、パラジウムの他、ロジウム、白金の使用及びこれらの併用ができ、担体としてはアルミナの他、シリカ、酸化チタンなどを用いることができる。触媒の添加量は通常5～15重量%程度である。また、これら酸化触媒層はディスペンサーによるディッピング等の方法で形成しても良い。

【0014】基板における酸化触媒層が設けられている検出部 α 付近の裏面はシリコン基板が異方エッチングにより除去されて薄くなっていて、酸化ケイ素層が露出してダイアフラム部 β を形成している。このような薄いダイアフラム部上に検出部 α を設けることにより、検出部の熱容量、及び、基板への熱伝導が小さくなり、消費電力の低減、センサ感度の向上等の効果が得られる。なおこの例では異方エッチングによりダイアフラム部 β を形成したが、サンドブラスト等の他の手段によっても良い。

【0015】ここで酸化触媒層5の厚さを変化させてセンサを作製し、これらセンサをイソブタンガスを3000ppm含む空気に暴露したときのセンサ出力への影響を調べた。なお、通常の使用状態の場合には数年間の使用を前提に1分毎に100ミリ秒間センサを用いてこれを繰り返すが、以下の検討では加速試験として、連続通電によってセンサの耐久性を評価した。ヒータ温度を450°Cに設定したときの結果を図2に示す。

【0016】図2により、酸化触媒層の厚さが10 μm である場合には、センサ出力は3日間で0mVとなってしまうが、10 μm 超であればこの連続通電試験で3日以上の寿命があることが判る。なお、この試験での3日間の寿命は通常の使用状態における5年間の寿命にほぼ相当し、従って、この加速試験においての3日以上の寿命は充分な長さであると評価される。一方、これらセンサについての消費電力について調べた結果を図3に示す。

【0017】図3より、触媒層の厚さが300 μm のとき消費電力が90mWとなることが判る。この値は、実

用上充分な測定方法である、毎分に100ミリ秒の使用を想定すると、通常用いられるリチウム電池2本で5年間使用できる電力量に相当する。また、通常、ガスセンサの交換は5年毎に行われることを考えあわせると、消費電力が90mW超の場合にはガスセンサ交換時期に先立って、電池交換がメンテナンスとして必要となるため、触媒層の厚さは300 μm 以下であることが望ましい。

【0018】

【発明の効果】本発明の接触燃焼式ガスセンサは、長寿命で優れた接触燃焼式ガスセンサであり、長期間メンテナンスフリーでの測定が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る接触燃焼式ガスセンサAを示すモデル図である。

(a) 上面図である。

(b) 断面図である。

【図2】触媒層の厚さを変化させて作製したセンサの経時変化を調べた結果を示す図である。

【図3】触媒層の厚さを変化させて作製したセンサの消費電力を調べた結果を示す図である。

【図4】従来技術に係る接触燃焼式ガスセンサBを示すモデル図である。

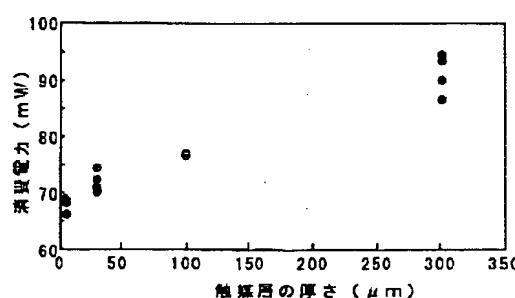
(a) 上面図である。

(b) 断面図である。

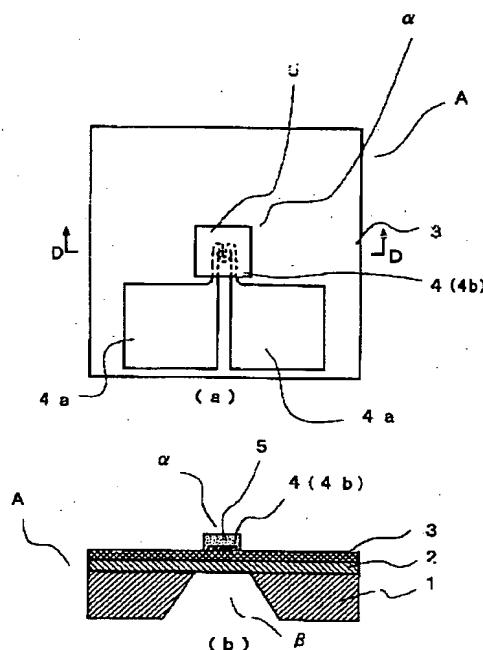
【符号の説明】

A	本発明に係る接触燃焼式ガスセンサ
B	従来技術に係る接触燃焼式ガスセンサ
α	検出部
β	ダイアフラム部
1	基板
2	酸化ケイ素層
3	窒化ケイ素層
4	ヒータ
4a	端子
4b	ヒータ部
5	酸化触媒層

【図3】

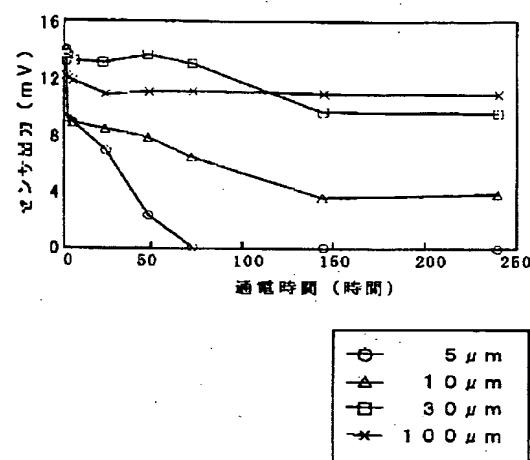


【図1】



α …検出部
 β …ダイアフラム部
 1…基板
 2…酸化ケイ素層
 3…電化ケイ素層
 4…ヒータ
 4 a…端子
 4 b…ヒータ部
 5…酸化触媒層

【図2】



【図4】

